PAT-NO:

JP363317922A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 63317922 A

TITLE:

PERPENDICULAR MAGNETIC RECORDING MEDIUM

PUBN-DATE:

December 26, 1988

INVENTOR-INFORMATION: NAME FURUSAWA, KENJI TAKAGAKI, ATSUSUKE ABE, KATSUO

INT-CL (IPC): G11B005/66, G11B005/706

US-CL-CURRENT: 428/694TS

ABSTRACT:

PURPOSE: To prevent the deterioration of soft magnetic films and to obtain a recording medium having large reproduced output and high recording density by providing intermediate films having specific crystal structures between a plated substrate and the soft magnetic films.

CONSTITUTION: The intermediate films 4 are provided between the plated substrate 1 and soft magnetic films 2 of a magnetic recording medium formed by laminating the soft magnetic films 2 and perpendicular magnetic anisotropy films 3 successively on the plated substrate 1. The intermediate films 4 are formed of a nonmagnetic metallic material having body-centered cubic crystal structure such as Cr, Mo, W, V, Nb, and Ta or a nonmagnetic metallic material having close packed hexagonal crystal structure such as Ti, Zr and Zn. Such intermediate films 4 prevent the special sepn. between the substrate 1 and the soft magnetic films 2 and suppress the desorption of the occluded gas in the substrate 1 and, therefore, the deterioration in the quality of the soft magnetic films 2 is prevented and the medium having the large reproduced output and the high recording density is obtd.

COPYRIGHT: (C)1988,JPO&Japid
KWIC

Abstract Text - FPAR (2):

CONSTITUTION: The intermediate films 4 are provided between the plated substrate 1 and soft magnetic films 2 of a magnetic recording medium formed by laminating the soft magnetic films 2 and perpendicular magnetic anisotropy films 3 successively on the plated substrate 1. The intermediate films 4 are formed of a nonmagnetic metallic material having body-centered cubic crystal

structure such as Cr, Mo, W, V, Nb, and Ta or a nonmagnetic metallic material having close packed hexagonal crystal structure such as Ti, Zr and Zn. Such intermediate films 4 prevent the special sepn. between the substrate 1 and the soft magnetic films 2 and suppress the desorption of the occluded gas in the substrate 1 and, therefore, the deterioration in the quality of the soft magnetic films 2 is prevented and the medium having the large reproduced output and the high recording density is obtd.

Title of Patent Publication - TTL (1):
PERPENDICULAR MAGNETIC RECORDING MEDIUM

昭63-317922 ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

MInt Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和63年(1988)12月26日

5/66 5/706 G 11 B

7350-5D 7350-5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全7頁)

垂直磁気記録媒体 図発明の名称 创特 願 昭62-153272 22出 昭62(1987)6月22日 頭 唘 司 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 72)発 明 者 古 熤 所生産技術研究所内 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 勿発 眀 者 髙 垣 篤 補 所生產技術研究所內 男 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 明 者 部 鵩 79発 冏 所生産技術研究所内

创出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

理 外1名 倒代 人 弁理士 小川 勝男

- 発明の名称 垂直磁気記録媒体
- 特許請求の範囲
 - 1. 非磁性基板上に、軟磁性膜をよび垂直磁気異 5 方性膜を順次積層して形成した二層膜構造の垂・ 直磁気記録媒体において、上記軟磁性膜と上記。 基板との間に、体心立方結晶構造もしくは稠密· 六方結晶構造を有する非磁性金属材料からなる: 中間膜を設けたことを特徴とする垂直磁気配録10 媒体。
 - 2. 中間膜が、体心立方結晶構造を有する Cr. Mo: W、V、NA、Taの金属、もしくはこれらの金属を・ 主成分とする合金のうちより選ばれる少なくと・ も1種の金属もしくは合金よりなることを特徴15 とする特許請求の範囲第1項に記載の垂直磁気、 **配録媒体。**
 - 3. 中間膜が、稠密六方結晶構造を有する Ti、2r、 Zn、Cd の金属、もしくはこれらの金属を主成分 とする合金のうちより選ばれる少なくとも1種。

. 1 .

- の金属もしくは合金よりなることを特徴とする特 許請求の範囲第1項に記載の垂直磁気配録媒体。
- 4. 中間膜の膜厚が 0.03 ~ 0.3 μm の範囲であるこ とを特徴とする特許請求の範囲第1項ないし第一 3項のいずれか1項に記載の垂直磁気記録媒体。
- 5. 軟磁性膜が、非晶質の Co Zr Mo 合金膜ま たは非晶質の Co-Zr-Nb 合金膜もしくは多結。 晶のパーマロイ膜であることを特徴とする特許。 請求の範囲第1項ないし第4項のいずれか1項 に記載の垂直磁気配録媒体。
- 6. 非磁性基板が非晶質の Ni P 合金めっき基板 . であることを特徴とする特許請求の範囲第1項・ ないし第5項のいずれか1項に配載の垂直磁気・ 記録媒体。
- 7. 垂直磁気異方性膜が Co-Cr 系合金薄膜である 15 ことを特徴とする特許請求の範囲第1項ないし . 第6項のいずれか1項に配載の垂直磁気配録媒体。.
- 3. 発明の詳細な説明
 - [産業上の利用分野]

本祭明は垂直磁気記録媒体に係わり、特に高密 20

度磁気配縁に好適な垂直磁気配録媒体に関する。 〔従来の技術〕

超密度化が可能な新しい磁気配録方式として、 垂直磁気記録方式が知られている。この高密度記 録方式に用いられる磁気配録媒体としては、垂直。 磁気異方性膜と軟磁性膜からなる二層複合膜が不 町欠とされている〔例えば、日本応用磁気学会誌. 第 8 巻、第 1 号、第 17 頁、昭和 59 年 Val. 8, A6 1, p17,1984)]。 この従来技術による垂直磁気配・ 録供体は、第6図に示すごとく、基板1上に軟磁™ 性膜2、および垂直磁気異方性膜3が積層されて・ いる。すなわち、基板1の両面には、軟磁性膜2. およびCo-Cr合金に代表される垂直磁気異方性膜・ 3が、それぞれ順次積層されている。軟磁性膜 2 · としては、現在、多結晶パーマロイ薄膜や非晶質 15 Co-Zr-Mo 薄膜などが用いられているが、後者・ の方が前者に比べて Co-Cr 合金薄膜の垂直磁気・ 異方性をより高めるとのことが特開昭 57 - 208631. 号公報に記載されている。一方、募板1としては.. (1) 高純度アルミニウム合金基体に、陽極酸化被膜 20

. 3 .

Cr 合金膜や軟磁性膜の膜質に及ぼす悪影響などについては全く配慮がされていなかった。

本発明者らの研究によると、めっき基板上に非 晶質 Co-Zr-Mo 合金よりなる軟磁性膜を形成し、 その上に Co-Cr 合金膜を形成させた二層膜構造の 垂直磁気配録媒体について、その再生出力と磁気 配録密度を検討した結果、Co-Cr 合金の単層膜と 同程度もしくはそれより若干上回る程度の再生出 力と記録密度しか得られず、大幅な特性改善をは かることは困難であることが分った。

本発明の目的は、上配従来技術の欠点を解決し、 再生出力が大きく、しかも高い配録密度が得られて る垂直磁気配録媒体を提供することにある。 〔問題点を解決するための手段〕

上配本発明の目的は、めっき基板と軟磁性膜と 13の間に、体心立方結晶構造もしくは稠密六方結晶・構造を有する非磁性の金属材料からなる中間膜を 2 設けた磁気記録媒体とすることにより、達成される。.

本発明の中間膜を構成する体心立方結晶構造を・ 有する非磁性金属材料としては、 Cr、Mo、W、V、so 層(厚さ数 um 程度)を形成させたアルマイト基板 (東北大学シンポジウム「垂直磁気配録」1982年 3月、p177)、(2)アルミニウム合金基体に無電解 または電解めっき法によって、非磁性 Ni - P 合金 膜を形成しためっき基板(東北大学シンポジウム。 「垂直磁気記録」 1982 年 3 月 p 197) 、(3) セラミ・ ックス基板、ガラス基板などがあるが、これらの・ 基板の中で、リジッド磁気ディスク用基板として・ は、現在、面内薄膜磁気ディスクに多く用いられ・ ている Ni - P 合金めっき基板が最適であるとされ ¹⁰ ている。かかるめっき基板上に、Co-Cr合金の垂: 直磁気異方性膜の単層を形成した垂直磁気記録媒・ 体は、特開昭 58 - 62823 号公報に配載のごとく、・ 耐久性の高い磁気記録媒体ではあるが、 Co - Cr · 合金の単層膜であるために、十分な再生出力と高い い記録密度が得られないという欠点があった。 [発明が解決しようとする問題点]

上述したごとく、従来技術において、Co-Cr合・ 金の単層膜や二層膜構造の垂直磁気配録媒体にお・ いては、めっき基板が、その上に形成されるCo-2o

Nb、Taなどの金属またはそれらの金属を主成分とする合金を挙げることができ、また、稠密六方結・晶構造の非磁性の金属材料としては、Ti、Zr、Zn、Caなどの金属またはそれらの金属を主成分とする合金を用いることができる。

〔作用〕

通常、薄膜を形成するに際して、基板との密着・性を向上させるために、また結晶性の薄膜であればその結晶性を向上させるために、基板を加熱す

Ni-P 合金めっき膜は、非晶質の非磁性材料で、あるが、加熱することにより結晶質に変化し、その際析出する Ni により強磁性となる。その臨界温・度は、P の含有量によって異なるものの、約 250・300 C 程度である。

上述した体心立方結晶構造もしくは稠密大方結 . 晶構造を有する非磁性金属材料からなる中間膜は . (1) 軟磁性膜を形成する際、めっき基板加熱時に生 . じるめっき基板袋面の極微な結晶化により、磁化 . されためっき基板の表面層と軟磁性膜との空隙的 20 分離の抑制、(2) めっき塞板内の吸蔵ガスの脱離を抑制し、軟磁性膜の膜質劣化を防止することができるものと考えられる。これにより、磁気配録媒体の再生出力が大きくなり、高い配録密度を有する二層膜構造の垂直磁気記録媒体が得られることになる。

〔実施例〕

以下に本発明の一実施例を挙げ、図面を参照しながらさらに詳細に説明する。

(実施例 1)

第1図は、本発明による垂直磁気記録媒体の断 : 面構造の一例を示す模式図である。図において、 : Ni-P 合金のめっき基板 1 の両面上には、中間膜 4 、軟磁性膜 2 、垂直磁気異方性膜 3 が、それぞれ順次積層されている。

めっき基板 1 としては、外径 130 mm、内径 40 mm... 厚さ 1.9 mmのアルミニウム合金の基体上に、厚さ15 ... μm の Ni – P 合金めっき膜を設けたものを用いた。 ... 軟磁性膜 2 としては非晶質 Co – Zr – Mo 合金膜を、... 垂直磁気異方性膜 3 としては Co – Cr 合金膜を、さ ...

7 .

することにより、 Co - Zr - Mo 合金膜の保磁力は 20. 以下となった。

一方、中間膜の最大膜厚は、 Co - Zr - Mo 合金膜の保磁力の値によって規制されることはないが中間膜の膜厚が厚くなることにより、その表面が荒れること、または内部応力が増大し中間膜にクラックが入ることを防止するため、最大 0.3 μm 程度が適当である。

次に、本実施例において作製した垂直磁気配録・ 媒体の記録特性について、従来例と比較して説明 ¹⁰ する。

第3図は、横軸に配録密度(**PCI)を、縦軸に再生出力(相対値)を示し、図中αはNi-P合金のめっき基板と Co-Zr-Mo合金よりなる軟磁性膜との間に中間膜として Cr 膜を設けた本発明の垂直磁気配録媒体を示し、図中 Δ は中間膜を設けない従来の垂直磁気配録媒体の再生出力を示している。これらは、垂直薄膜ヘッド(ヘッドギャップ 0.2 μm)を、 0.2 μm の浮動スペーシングで浮上させ測定した結果である。

. 9 .

らに Ni - P 合金のめっき基板 1 と軟磁性膜 2 との 間の中間膜 4 として体心立方結晶構造を有するCr・ 膜をそれぞれスパッタ法により形成させた。この・ 時の成膜条件を第 1 表に示す。

第 1 表

	中 間 膜 (c+膜)	軟 磁 性 膜 (Co-Zr-Mo合金膜)	無直磁気異方性膜 (C o - C+ 合金膜)
基板温度	150°C	150°C	100~150°C
スパッタ電力	1 k #/	1 <i>kW</i>	1 k W
Ar ガス圧	5 m Torr	5 m T o T T	5 m Torr
膜 厚	0.01~0.4µm	0.2~0.5 µm	0.15~0.2 µm

中間膜として、Cr膜を選んだ場合の、軟磁性膜・である Co - Zr - Mo 合金膜の保磁力 Bo (Oc)とCr・膜厚 (μm) との関係を第2図に示す。図から明ら15かなごとく、Cr膜の膜厚を0.03μm 以上にすれば、Co - Zr - Mo 合金よりなる軟磁性膜の保磁力を十.分に小さくすることができる。このような傾向は、中間膜を Mo、W、V、Nb、Ta 膜に変えても経控同じ、傾向にあり、総じて0.03μm 以上の厚さの中間膜と20

. 8 .

第3図より、中間膜として Cr 膜を設けることにより、配録密度 Dsoが 46 kPCI から 58 kPCI に再生出力(相対値)が 1.0 から 1.10 に、それぞれ増加していることがわかる。この傾向は、Cr 膜を Mo、 W、 V、 Nb または Ta 膜に変えてもほぼ同様であった。また、 Cr、 Mo、 W、 V、 Nb、 Ta などの金属を主成分とする体心立方結晶構造の合金にかいても本実施例と同様の効果を得ている。

以上の結果から、Crなどの体心立方結晶構造を「有する非磁性金属材料からなる中間膜をNi-P合」の金のめっき基板と Co-Zr-Mo 合金よりなる非晶・質軟磁性膜との間に設けることにより、Co-Zr-・Mo 合金よりなる軟磁性膜の保磁力 Ho を減少させ・ることができ、垂直磁気配録媒体の再生出力、配・録密度を著しく向上できることが分かる。

 表面層と軟磁性膜との空隙的分離の抑制、(2) めっき 基板内の吸蔵ガスの脱離抑制にあるので、成膜 手法としてスパッタ法に限定されるものではなく 真空蒸発法、イオンプレーティング法などのベー パデポジション法においても有効である。さらに 軟磁性膜の一例として Co-Zr-Mo合金膜を例に挙げ 脱明したが、非晶質 Co-Zr-Nb合金膜、多結晶パーマロイ膜などについても、本実施例とほぼ同様の効果が得られることを確認している。 (実施例 2)

中間膜として、稠密六方結晶構造を有する Ti 膜・を用いた以外は、実施例 1 と同様にして垂直磁気・記録媒体を作製した。

中間膜として、Ti膜を選んだ場合の軟磁性膜で・ある Co - Zr - Mo 合金膜の保磁力 Ho (Or)と Ti 膜 II 厚 (μm) との関係を第 4 図に示す。図から明らか、なごとく、Ti 膜の膜厚を 0.03 μm 以上にすれば、 . . Co - Zr - Mo 合金よりなる軟磁性膜の保磁力を十、分に小さくすることができる。このような傾向は、中間膜を Zr、 Zn または Cd 膜に変えてもほぼ同じ。

. 11 .

した結果である。

第 5 図より、中間膜として Ti 膜を設けることに、より、配録密度 Dso が 46 k P C I から 60 k F C I に、再生出力(相対値)が 1.0 から 1.13 に、それぞれ増加していることがわかる。この傾向は、Ti 膜を Zr、Zn または Cd 膜に変えてもほぼ同様の結果が得られた。また Ti、Zr、Zn、Cd などの金属を主成分とする稠密六方結晶構造の合金においても本実施のと同様の効果を得ている。

以上の結果から、Tiなどの稠密六方結晶構造を *** 有する非磁性金属材料からなる中間膜をめっき基・板と Co-Zr-Mo 合金よりなる非晶質軟磁性膜と の間に設けることにより、 Co-Zr-Mo 合金よりなる軟磁性膜の保磁力 Hcを減少させることができ、 垂直磁気配録媒体の再生出力、配録密度を著しく *** 向上できることが分かる。

 傾向にあり、総じて 0.03 μm 以上の厚さの中間膜とすることにより、 Co - Zr - Mo 合金膜の保磁力は 2 O · 以下となった。

一方、中間膜の最大膜厚は、Co- Zr- Mo 合金膜 の保磁力の値によって規制されることはないが、 5中間膜の膜厚が厚くなることにより、その表面が 元れること、またクラックの発生を防止すること、 さらには量産性の面を考慮すると最大 Q3 μm 程度 が適当である。

次に、本実施例において作製した垂直磁気配録 10 媒体の記録特性について、従来例と比較して説明・ する。

第5図は、横軸に配録密度(*PCI)を、縦軸・に再生出力(相対値)を示し、図中 a' は Ni - P 合・金めっき基板と Co - Zr - Mo 合金よりなる軟磁性膜 15の間に中間膜として Ti 膜を設けた本発明の垂直磁・気配録媒体を示し、図中 b' は中間膜を設けない従・来の垂直磁気配録媒体の再生出力を示している。 これらは、垂直薄膜ヘッド(ヘッドギャップ 0.2 μm) ・を、0.2 μm の浮動スペーシングで浮上させて測定 20

· 12 ·

本質は、(1) 磁化されためっき基板の表面層と軟磁性膜との空隙的分離の抑制、(2) めっき基板内の吸蔵ガスの脱離抑制にあるので、成膜方法としてスパッタ法に限定されるものではなく、真空蒸着法、イオンプレーティング法などのペーパデポジショ 5 ン法においても有効である。さらに、軟磁性膜の一例として Co - Zr - Mo 合金膜を例に挙げ説明したが、非晶質 Co - Zr - Nb 合金膜、多結晶パーマーイ膜などについても、本実施例とほぼ同様の効果が得られることを確認している。

〔発明の効果〕

以上詳細に説明したごとく、本発明の垂直磁気・記録媒体によれば、めっき基板と軟磁性膜との間・に Cr、Mo、W、V、Nb、Ta などの体心立方結晶構・造を有する非磁性金属材料、もしくは Ti、2r、 15 Zn、Cd などの稠密六方結晶構造を有する非磁性・金属材料からなる中間膜を設けることにより、め、っき基板の軟磁性膜に及ぼす悪影響を防止する。とができ、軟磁性膜の保磁力が小さくなり磁気特・性が向上するので、磁気記録媒体としての記録特。

性が著しく向上する。

4. 図面の簡単な説明

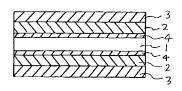
. 15 .

- 1 ……… めっき基板
- 2 軟磁性膜
- 3 垂直磁気異方性膜
- 4 ……中間膜

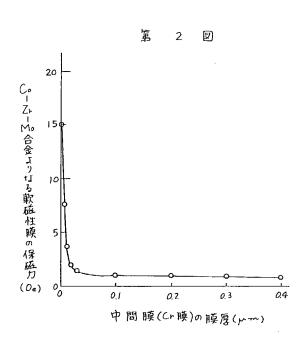
代理人 弁理士 小 川 勝



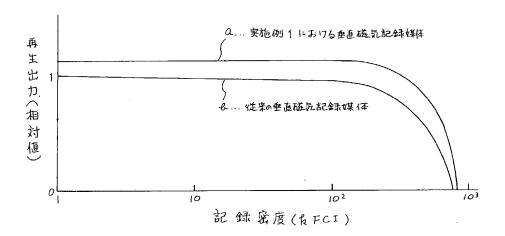
第1区

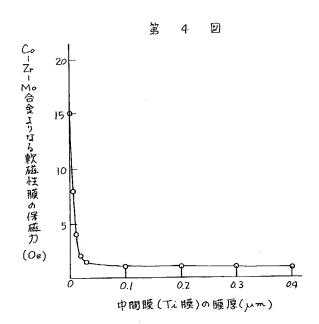


- 1. めっき基板
- 2 軟磁性膜
- 3. 垂直磁気點大性膜
- 4. 中間膜

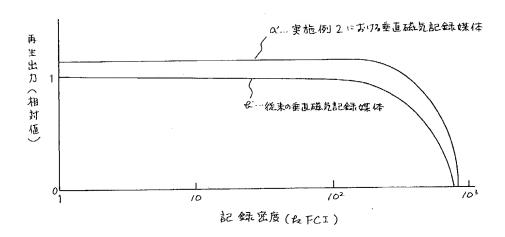




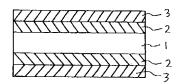




第 5 **3**



第6図



- 1. めっき基板
- 2. 軟磁性膜 3. 垂直磁気異方性膜